

1344100

Эмб + 10мк

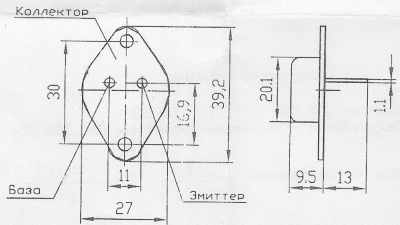
28.05.88



Транзисторы 2Т878А,
2Т878Б, 2Т878В

Э Т И К Е Т К А

Кремниевые эпитаксиально-планарные N-P-N мощные переключаательные высоковольтные транзисторы 2Т878А, 2Т878Б, 2Т878В в металло-стеклянном корпусе КТ-9, предназначенные для работы в переключа-тельных схемах, импульсных модуляторах, во вторичных источниках питания и другой аппаратуре специального назначения.



Основные электрические параметры при T=25°C

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора, мА 2Т878А (Uкб=800В) 2Т878Б (Uкб=600В) 2Т878В (Uкб=900В)	Iкбо	-	3
Обратный ток эмиттера (Uэб=6В), мА	Iэбо	-	40
Статический коэффициент передачи тока (Uкэ=5В, Iк=10А)	h21э	12	50
Граничное напряжение (к=0,1А, L=40мГн), В 2Т878А 2Т878Б 2Т878В	Uкэогр	400 300 450	- - -
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В (Iк=15А, Iб=3А)	Uкэ нас	-	1,5
Время спада (Uкэ=300В, Iк=10А, Iб1=Iб2=2А), мкс 2Т878А, 2Т878Б 2Т878В	Uбэ нас	- -	0,5 0,3

Содержание драгоценных металлов в одном транзисторе:
золото — 0.02250x4 г
серебро —


Выхода драгметаллов не содержат.

Содержание цветных металлов в одном транзисторе:
медь — 0,41 г.
молибден — 3 г.

Сведения о приемке

Транзисторы 2Т878А, 2Т878Б, 2Т878В
соответствуют техническим условиям АА0.339.574 ТУ.

Приняты по извещению N 1 от 4.03.2008.
дата

Штамп ОТК 

Штамп ПЗ 

Перепроверка проведена _____
дата

Приняты по извещению N _____ от _____
дата

Штамп ОТК

Штамп ПЗ